1. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1042-1046, 2006.
2. **Daigo KIKUTA, Jin-Ping Ao, Junya MATSUDA *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1031-1036, 2006.
3. **K. Matsuura, D. Kikuta, Jin-Ping Ao, H. Ogiya, M. Hiramoto, H. Kawai *and* Yasuo Ohno :** ICP Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN HFET, *The 2006 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2006),* Yokohama, Sep. 2006.
4. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A Monolithic Cockcroft-Walton Voltage Multiplier Based on AlGaN/GaN HFET Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
5. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-Sensitivity UV Phototransistor with GaN/AlGaN/GaN Gate Epi-Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
6. **岡田 政也, 松浦 一暁, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaNキャップ層ピエゾ電荷を用いたエンハンスメントモードAlGaN/GaN HFET, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
7. **石尾 隆幸, 岡田 政也, 敖 金平, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧の温度依存性の測定, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
8. **山岡 優哉, 岡田 政也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧のゲートストレスバイアス依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
9. **菅 良太, 佐藤 弘明, 敖 金平, 小中 信典, 入谷 忠光, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間ミリ波信号伝送, *2006年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2006年9月.
10. **岡田 政也, 国貞 雅也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaN/AlGaN/GaNフォトトランジスタを用いたUVセンサ回路, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
11. **奥山 祐加, 菅 良太, 佐藤 弘明, 小中 信典, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における位置ずれの影響, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
12. **Kazuaki Matsuura, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Hiromichi Ogiya, Michihiro hiramoto, Hiroji Kawai *and* Yasuo Ohno :** Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field Effect Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.46,** *No.4B,* 2320-2324, 2007.
13. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-sensitivity UV phototransistor with GaN/AlGaN/GaN gate epi-structure, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.204,** *No.6,* 2117-2120, 2007.
14. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A monolithic Cockcroft-Walton voltage multiplier based on AlGaN/GaN HFET structure, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2654-2657, 2007.
15. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Annealing with Ni for ohmic contact formation on ICP-etched p-GaN, *Electronics Letters,* **Vol.44,** *No.2,* 155-157, 2008.
16. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
17. **Cheng-Yu Hu, K. Matsuura, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Ohmic Contact for Dry-Etched p-GaN Realized by High Temperature Annealing, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
18. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, M. Okada, M. Sugimoto, T. Uesugi, T. Kachi *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact Formation to Dry-Etched p-GaN, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors,* Kyoto, Oct. 2007.
19. **大野 泰夫, 山岡 優哉, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平 :** ゲートストレスバイアスによるAlGaN/GaN MIS HFETの電流コラプス評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
20. **野久 保宏幸, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN MISダイオードによる絶縁膜界面評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
21. **澤田 剛一, 新海 聡子, 敖 金平, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** n‐GaNへの高温処理ZrN電極ショットキー特性, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
22. **胡 成余, 岡田 政也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** Ni処理を用いたドライエッチp‐GaNへの低抵抗オーミック形成, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
23. **敖 金平, 澤田 剛一, 新海 聡子, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** TiNゲートAlGaN/GaN HFETの特性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
24. **奥山 祐加, 柏原 俊彦, 敖 金平, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間マイクロ波信号伝送, *2007年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2007年9月.
25. **伊藤 秀起, 高橋 健介, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** マイクロ波整流用GaNショットキーダイオードの特性評価, *2008年電子情報通信学会総合大会,* 2008年3月.
26. **胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** p-基板層付きAlGaN/GaN HFETのVt-Vsub特性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
27. **高橋 健介, 伊藤 秀起, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** GaNを用いたマイクロ波整流用ショットキーバリアダイオード, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
28. **Masaya Okada, Hideki Ito, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Mechanism of AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistor Threshold Voltage Shift by Illumination, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.4,* 2103-2107, 2008.
29. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, Masaya Okada *and* Yasuo Ohno :** A Study on Ohmic Contact to Dry-Etched p-GaN, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1020-1024, 2008.
30. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1004-1008, 2008.
31. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 72-74, 2008.
32. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 75-79, 2008.
33. **K. Takahashi, Jin-Ping Ao, Y. Ikawa, C. -Y. Hu, H. Kawai, N. Shinohara, N. Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
34. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Daigo Kikuta, Masahiro Sugimoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** VT-VSUB Characterization of AlGaN/GaN HFET with Regrown Epi-layer on p-GaN, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
35. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
36. **Heng-Yu Xu, Jin-Ping Ao, Hui Yu, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Device Isolation for AlGaN/GaN HFET Utilizing Heavy Metal Diffusion, *IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 2008 (NMDC2008),* Kyoto, Oct. 2008.
37. **Ikuo Awai, Kunihito Hori, Yuka Okuyama *and* Yasuo Ohno :** Non-contact Signal Transmission Based on Open Ring Resonator BPF, *Proceedings of the 38th European Microwave Conference,* Amsterdam, Oct. 2008.
38. **Naoki Shinohara, Yushi Miyata, Tomohiko Mitani, Naoki Niwa, Kenji Takagi, Kenichi Hamamoto, Satoshi Ujigawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** New Application of Microwave Power Transmission for Wireless Power Distribution System in Buildings, *Asia Pacific Microwave Conference 2008,* Hong Kong, Dec. 2008.
39. **敖 金平, 許 恒宇, 于 僡, 胡 成余, 大野 泰夫 :** Ni拡散によるAlGaN/GaN HFET素子分離, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
40. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET VT-VSUB特性を用いたp-GaN上バッファ層の評価, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
41. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ表面負帯電におけるDC特性の解析, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
42. **宮田 侑是, 篠原 真毅, 三谷 友彦, 丹羽 直幹, 高木 賢二, 浜本 研一, 宇治 川智, 高橋 健介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNショットキーダイオードを用いた大電力レクテナの研究開発, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
43. **阿部 まみ, 奥山 祐加, 倉本 健次, 黒田 健太郎, 佐藤 弘明, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における損失の検討, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
44. **澤田 剛一, 敖 金平, 許 恒宇, 高橋 健介, 胡 成余, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** p型表面層を持つマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
45. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETにおける仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
46. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** p層上デュアルゲートAlGaN/GaN HFETにおけるアバランシェホール電流の測定, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
47. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 大野 泰夫, 菊田 大悟, 杉本 雅裕 :** VT-VSUB特性を用いたp-GaN上のAlGaN/GaN HFETバッファ層評価, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
48. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
49. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
50. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
51. **大野 泰夫 :** 共振器結合を用いたワイアレス電力伝送, *日本機械学会マイクロナノ工学専門会議マイクロエネルギー研究会第三回会合,* 2009年3月.
52. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN-based Schottky Diodes, Handbook of Light Emitting and Schottky Diode Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, May 2009.
53. **Kensuke Takahashi, Jin-Ping Ao, Yusuke Ikawa, Cheng-Yu Hu, Hiroji Kawai, Naoki Shinohara, Naoki Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C095, 2009.
54. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C025, 2009.
55. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai *and* Yasuo Ohno :** Schottky Contacts of Reactive Sputtering Refractory Metal Nitrides on Gallium Nitride, *The 10th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 433-436, Kanazawa, Jul. 2009.
56. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer layer doping concentration measurement using VT-VSUB Characterization of GaN HEMT with p-GaN substrate layer, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
57. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
58. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** MIS Diode Characterization on n-GaN by C-V Measurement at 150 C, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
59. **Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of GaN MOSFET with TEOS SiO2 Gate Insulator, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
60. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact to Deeply Dry-etched p-GaN, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
61. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Monitoring and control of substrate voltage for AlGaN/GaN HEMTs with p-GaN epi-layer, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
62. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスのステップストレス測定, *第70回応用物理学会学術講演会,* 2009年9月.
63. **下村 輝, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** ミリはインターコネクトにおける設置面の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
64. **高橋 健介, 敖 金平, 胡 成余, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** マイクロ波電力整流用GaNショットキーダイオードのSパラメータ解析, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
65. **倉本 健次, 阿部 まみ, 奥山 祐加, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いた非接触広帯域入出力インターフェイス, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
66. **阿部 まみ, 倉本 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
67. **大野 泰夫 :** 無線送電とワイドギャップ半導体, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
68. **阿部 まみ, 倉本 健次, 天羽 孝文, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 誘電率の異なる基板間でのオープンリング共振器無線接続, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
69. **中谷 克俊, 祖川 雄司, 金 栄現, 敖 金平, 大野 泰夫, 宮下 準弘, 本山 慎一 :** プラズマCVD酸化膜を用いたGaN MOSFET, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
70. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスにおける光照射の影響, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
71. **大野 泰夫 :** 化合物半導体電子デバイス開発の軌跡, *電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会資料,* 2009年6月.
72. **野崎 兼史, 高橋 義也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンゲートAlGaN/GaN HFETの電解質溶液を介した電流制御, *電子情報通信学会センサーデバイス・MEMS・一般研究会,* 2009年7月.
73. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** ステップストレス測定によるAlGaN/GaN HFET電流コラプス解析, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
74. **高橋 健介, 敖 金平, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 藤原 暉雄, 大野 泰夫 :** マイク ロ波無線ユビキタス電源用GaNショットキーダイオードの開発, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
75. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masanari Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Metal Insulator Semiconductor Diode Characterization on n-GaN by Capacitance Voltage Measurement at 150 °C, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF11, 2010.
76. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** GaN Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor with Tetraethylorthosilicate SiO2 Gate Insulator on AlGaN/GaN Heterostructure, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF09-1-04DF09-4, 2010.
77. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Schottky contacts of refractory metal nitrides on gallium nitride using reactive sputtering, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1439-1443, 2010.
78. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1218-1224, 2010.
79. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer Layer Doping Concentration Measurement Using VT-VSUB Characteristics of GaN HEMT with p-GaN Substrate Layer, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1234-1237, 2010.
80. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.276,** *No.1,* 012001-1-012001-4, 2011.
81. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Shiro Akamatsu, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with a gate SiO2 insulator deposited by silane-based plasma-enhanced chemical vapor deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 457-460, 2011.
82. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Gate SiO2 Deposited by Silane-Based PECVD, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* Takamatsu, May 2010.
83. **Mami Abe, Takahumi Amou, Kenji Kuramoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effects of Substrate Conductivity on Open-Ring Resonator Wireless Interconnection, *2010 Asia-Pacific Radio Science Conference,* Toyama, Sep. 2010.
84. **Jin-Ping Ao, Kensuke Takahashi, Naoki Shinohara, Naoki Niwa, Teruo Fujiwara *and* Yasuo Ohno :** S-parameter Analysis of GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *2010 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium,* Monterey, Oct. 2010.
85. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *2nd Photonics and Optoelectronics Meetings (POEM2010),* Wuhan, Nov. 2010.
86. **Mami Abe, Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Misalignment Effects in Inter-Chip Wireless Connection with Open-Ring Resonators, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
87. **Yasuo Ohno :** Application of GaN Devices to Wireless Power Transmission, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
88. **阿部 まみ, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
89. **原内 健次, 細川 大志, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードのSパラメータ解析, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
90. **細川 大志, 原内 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードの二次元デバイスシミュレーション, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
91. **原内 健次, 岩崎 裕一, 阿部 まみ, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器接続によるマイクロ波無線電力伝送, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2011年3月.
92. **細川 大志, 黒田 健太郎, 井谷 祥之, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流コラプスの回復過程測定, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2011年3月.